

2008年5月1日

委員各位

日本学術振興会
結晶加工と評価技術第145委員会
委員長 田島 道夫

(独)日本学術振興会「結晶加工と評価技術」第145委員会
第114回研究会・委員総会開催通知

日時：2008年6月13日(金)

会場：明治大学駿河台キャンパスアカデミーコモン2階ビクトリーフロア暁の鐘A4会議室

http://www.meiji.ac.jp/koho/campus_guide/suruga/access.html

東京都千代田区神田駿河台1-1 (TEL 03-3296-4545)

JR中央線・総武線、東京メトロ丸ノ内線/御茶ノ水駅 下車徒歩3分

東京メトロ千代田線/新御茶ノ水駅 下車徒歩5分

都営地下鉄三田線・新宿線、東京メトロ半蔵門線/神保町駅 下車徒歩5分

テーマ「新規MOSFETにおける歪と結晶の制御」

世話人：小椋 厚志 (明治大学)、酒井 朗 (大阪大学)

プログラム

- 13:00~13:10 開会の挨拶 田島道夫、酒井 朗
- 13:10~13:50 「ダイヤモンドプロセスとローカル歪技術を用いた高性能Metal/High-k gate MOSFET」
黛 哲 (ソニー(株) セミコンダクタテクノロジー開発部門)
- 13:50~14:30 「ひずみSi/SGOI構造MOSFETにおける閾値ばらつきの解析」
入沢 寿史 ((株)東芝 研究開発センター)
- 14:30~15:10 「JEITA標準歪み測定WG成果報告」
中 庸行 ((株)堀場製作所 半導体システム開発部)
- 15:10~15:30 休憩
- 15:30~16:10 「Nano Beam DiffractionによるLSI微小領域の歪み測定」
高口 雅成 ((株)日立製作所 中央研究所)
- 16:10~16:50 「Direct Silicon Bonding基板の開発と結晶評価」
豊田 英二 (コバレントマテリアル(株) シリコン事業本部)
- 16:50~17:30 「Si(111)基板上InGaAsチャネル層の微小領域選択成長」
杉山 正和 (東京大学大学院工学系研究科 総合研究機構)
- 17:45~18:00 委員会総会
- 18:00~19:45 懇親会 (場所:同A5会議室)

以上